
2SD1559

シリコン NPN 三重拡散形

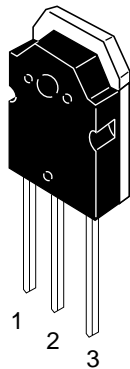
HITACHI

特長

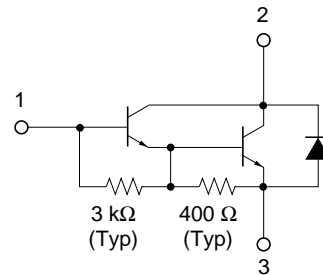
- 低周波電力増幅用
- 2SB1079 とコンプリメンタリペア

外観図

TO-3P



1. Base
2. Collector (Flange)
3. Emitter



絶対最大定格

(Ta = 25)

項目	記号	2SD1559	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	100	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	100	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	I_C	20	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	30	A
ベース電流	I_B	3	A
許容コレクタ損失	P_C^{*1}	100	W
接合部温度	T_J	150	
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	

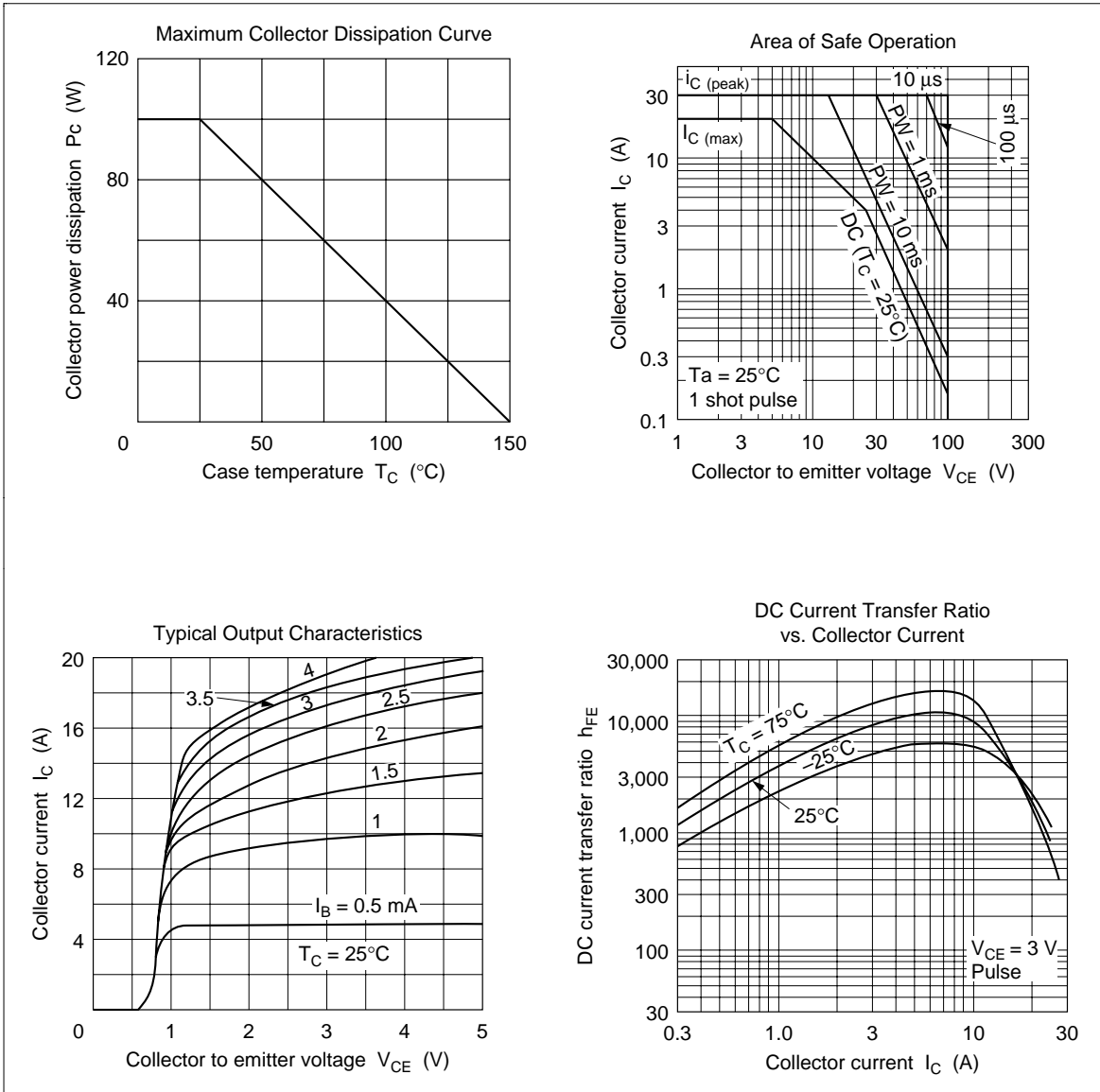
【注】 1. $T_C = 25$ における許容値

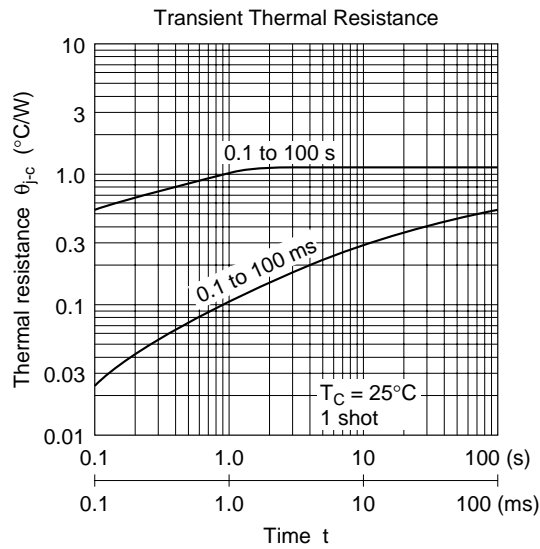
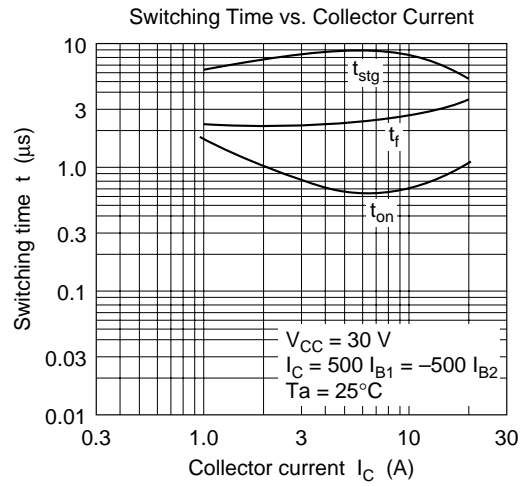
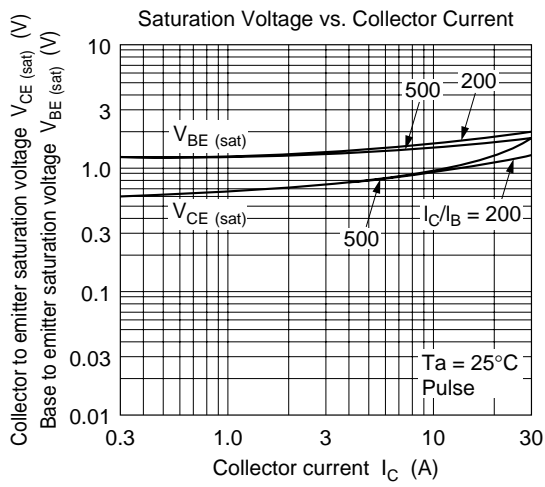
電気的特性

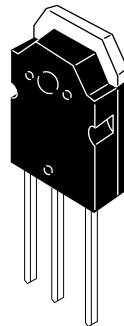
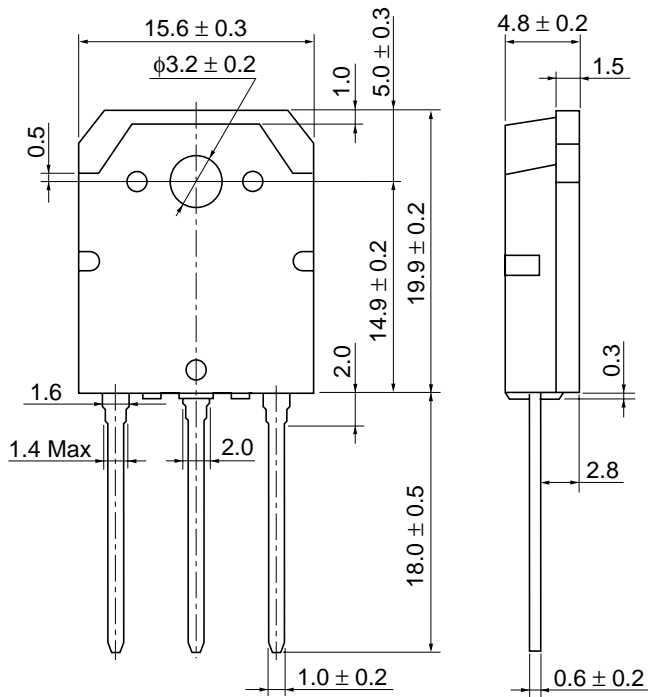
(Ta = 25)

項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	100	—	—	V	$I_C = 0.1mA, I_E = 0$
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	100	—	—	V	$I_C = 25mA, R_{BE} =$
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CEO(sus)}$	100	—	—	V	$I_C = 200mA, R_{BE} =$ *1
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	7	—	—	V	$I_E = 50mA, I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	100	μA	$V_{CB} = 100V, I_E = 0$
	I_{CEO}	—	—	1.0	mA	$V_{CE} = 80V, R_{BE} =$
直流電流増幅率	h_{FE}	1000	—	20000		$V_{CE} = 3V, I_C = 10A^{*1}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)1}$	—	—	2.0	V	$I_C = 10A, I_B = 20mA^{*1}$
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)1}$	—	—	2.5	V	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)2}$	—	—	3.0	V	$I_C = 20A, I_B = 200mA^{*1}$
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)2}$	—	—	3.5	V	
ターンオン時間	t_{on}	—	1.0	—	μs	$I_C = 10A, I_{B1} = -I_{B2} = 20mA$
蓄積時間	t_{stg}	—	9.0	—	μs	
下降時間	t_f	—	3.0	—	μs	

【注】 1. パルス測定







Hitachi Code	TO-3P
JEDEC	—
EIAJ	Conforms
Weight (reference value)	5.0 g